

激光测距用高精度时间测量(TDC)电路

主要特点

- 双通道单精度模式 55ps
- 单通道双精度模式 27ps
- 非校准测量范围 3.5ns(0ns)至 25μs
- 单精度校准测量范围 3.5ns(0ns)至 16μs
- 双精度校准测量范围 3.5ns 至 4μs
- 20ns 最小脉冲间隔，双通道最多可接收 20 个脉冲
- 非校准模式下，对于单精度测量时间间隔在 3μs 以内，可以设置 REG[2] = 1，只读低 16 位结果，加快读取时间
- 4 线 SPI 通信接口
- 工作电压：2.5V 至 3.6V
- 工作温度：-40°C 至+125°C
- QFN20 封装

产品简述

MS1006N是一款高精度时间测量(TDC)电路。对比MS1002具有更高的精度和更小的封装，对比MS1005可以实现更高的测量频率。

MS1006N具有双通道、多脉冲的采样能力、高速SPI通讯、多种测量模式，适合于激光雷达和激光测距。

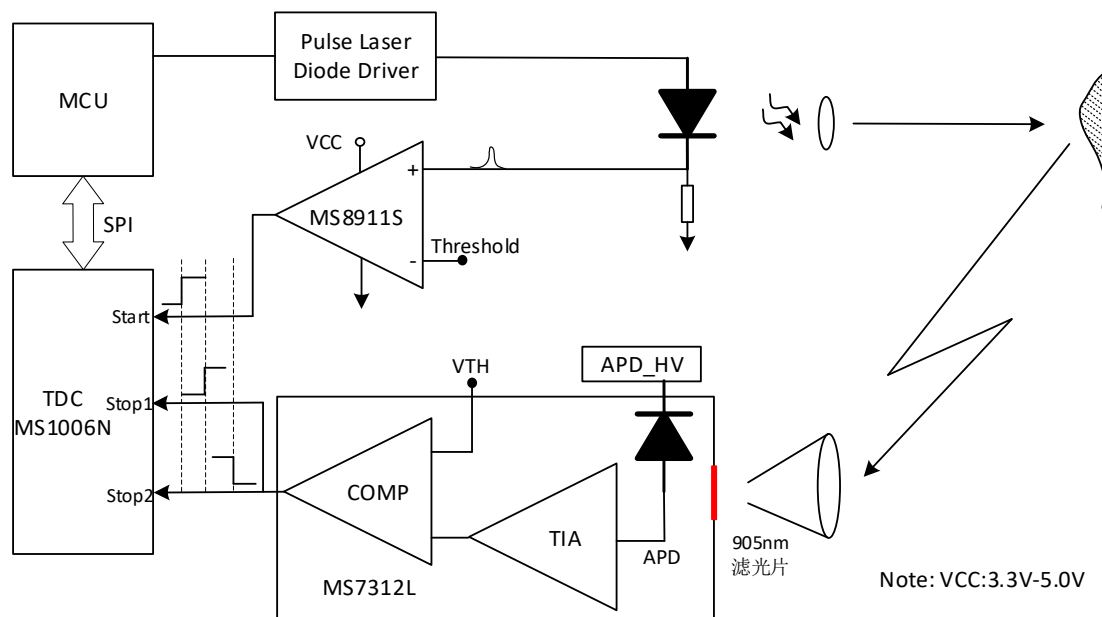
应用

- 激光雷达
- 激光测距
- 脉冲测量

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS1006N	QFN20	MS1006N

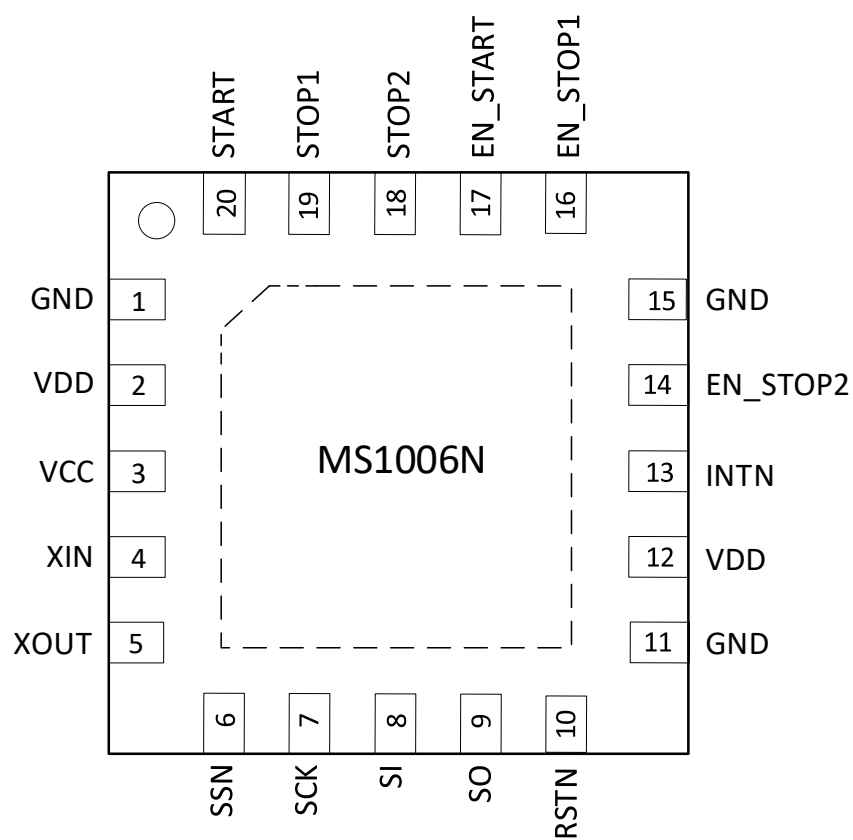
系统框图



目录

1. 主要特点.....	1
2. 产品简述.....	1
3. 应用.....	1
4. 产品规格分类.....	1
5. 系统框图.....	1
6. 目录.....	2
7. 管脚图.....	3
8. 管脚说明.....	4
9. 内部框图.....	5
10. 极限参数.....	6
11. 推荐工作条件.....	6
12. 电气参数.....	7
12.1 直流电气参数.....	7
12.2 终端等效电容.....	7
12.3 时间测量单元.....	7
12.4 时钟振荡器.....	7
13. 功能描述.....	8
13.1 SPI 接口.....	8
13.2 关闭 STOP 通道的时序.....	9
13.3 系统复位时序.....	9
13.4 操作码及寄存器.....	10
13.4.1 配置寄存器.....	10
13.4.2 操作码.....	11
13.4.3 结果寄存器.....	12
13.4.4 读取配置寄存器低 8 位.....	12
13.4.5 读取状态寄存器(STAT).....	13
13.5. 时间测量.....	13
13.5.1 概述.....	13
13.5.2 高精度时间测量原理.....	13
13.5.3 非校准时间测量.....	15
13.5.3.1 非校准时间测量概述.....	15
13.5.3.2 寄存器设置.....	15
13.5.3.3 测量流程.....	17
13.5.4 校准时间测量.....	20
13.5.4.1 校准时间测量概述.....	20
13.5.4.2 寄存器设置.....	20
13.5.4.3 测量流程.....	22
13.6 高速振荡器.....	23
13.7 快速初始化.....	23
14. 典型应用图.....	25
15. 封装外形图.....	26
16. 印章与包装规范.....	27
17. 声明.....	28
18. MOS 电路操作注意事项.....	29

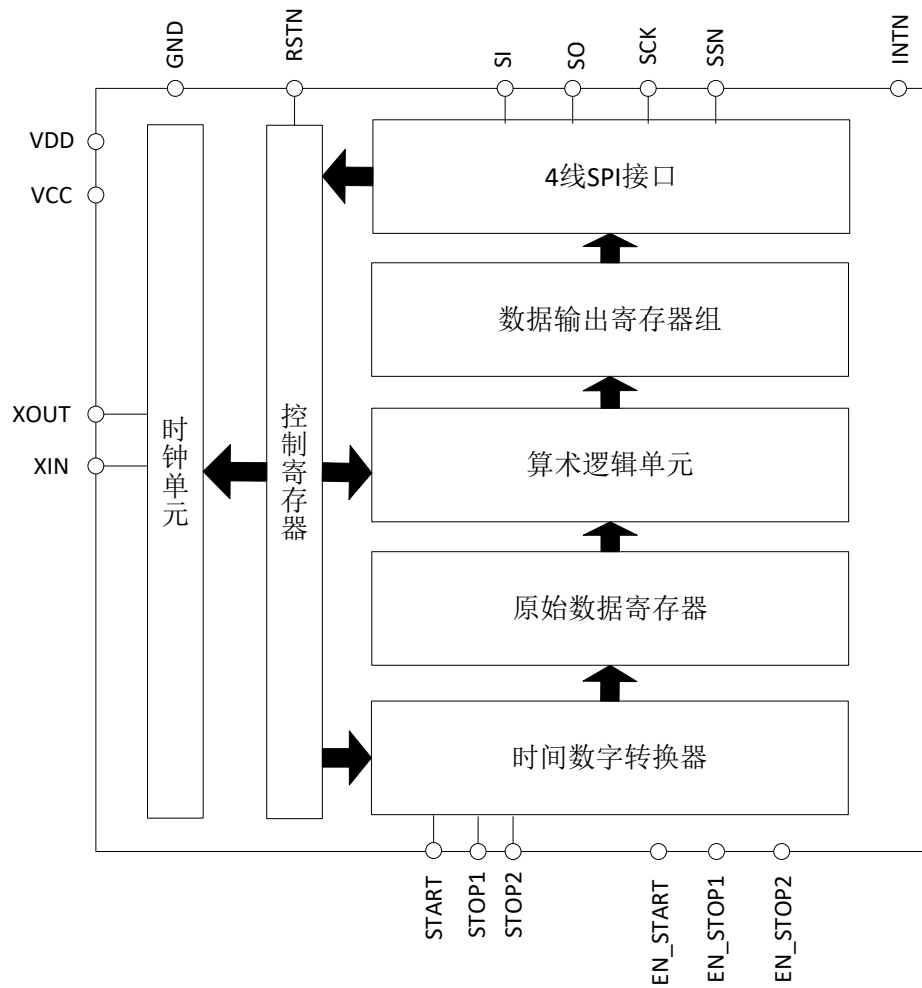
管脚图



管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	GND	-	地
2	VDD	-	内核电源
3	VCC	-	端口电源
4	XIN	I	高速晶振驱动输入
5	XOUT	O	高速晶振驱动输出
6	SSN	I	SPI 接口从机选择，低电平有效
7	SCK	I	SPI 接口时钟输入
8	SI	I	SPI 接口数据输入
9	SO	O	SPI 接口数据输出；SPI 空闲时高阻
10	RSTN	I	系统复位输入，低电平有效
11	GND	-	地
12	VDD	-	内核电源
13	INTN	O	中断标志，低电平有效
14	EN_STOP2	I	Stop 通道 2 使能端口，高电平有效
15	GND	-	地
16	EN_STOP1	I	Stop 通道 1 使能端口，高电平有效
17	EN_START	I/O	EN_START 内部上拉 Start 使能， 可通过设置寄存器设置为 EN_START 输入，高电平有效
18	STOP2	I	Stop 通道 2
19	STOP1	I	Stop 通道 1
20	START	I	Start 通道

内部框图



极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
内核供电电压	V_{DD}	-0.3 ~ 4	V
IO 供电电压	V_{CC}	-0.3 ~ 4	V
输入管脚电压	V_{IN}	-0.5 ~ $V_{CC}+0.5$	V
存储温度	T_{STG}	-65 ~ 150	°C
工作温度	T_A	-40 ~ 125	°C
焊接温度(10s)	T_{SOLDER}	260	°C
ESD (HBM)	V_{HBM}	>6	kV

推荐工作条件

除非另外说明， $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
内核供电电压 ¹	V_{DD}	$V_{CC} = V_{DD}$	2.5		3.6	V
IO 供电电压	V_{CC}		2.5		3.6	V
输入信号上升沿时间	t_{RI}				200	ns
输入信号下降沿时间	t_{FA}				200	ns
工作温度	T_A		-40		125	°C

注 1：包括晶振管脚 XIN、XOUT。

电气参数

直流电气参数

除非另外说明， $V_{CC} = V_{DD} = 3.3V$ ， $T_A = 25^\circ C$ 。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
4MHz 晶振电流	I_{HS}	$V_{CC}=V_{DD}= 3.6V$		220		μA
		$V_{CC}=V_{DD}=3.0V$		130		μA
		关闭时		<1		μA
工作电流	I_o	TOF ($V_{CC}=V_{DD}=3.3V$)		2		mA
高电平输出电压	V_{OH}	$V_{CC}=Max$	$0.8V_{CC}$			V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_{CC}=Min$			$0.2V_{CC}$	V
高电平输入电压	V_{IH}	LVTTL, $V_{CC} = Max$	$0.7V_{CC}$			V
低电平输入电压	V_{IL}	LVTTL, $V_{CC}= Min$			$0.3V_{CC}$	V

终端等效电容

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
数字输入端口电容	C_{IN}	$V_{CC} = V_{DD}$, $f = 1MHz$, $T_A=25^\circ C$		7		pF
数字输出端口电容	C_O			3		pF
双向端口电容	C_{IO}			9		pF

时间测量单元

除非另外说明， $V_{CC}=V_{DD}=3.3V$ ， $T_A=25^\circ C$ 。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
测量分辨率	LSB	DOUBLE_RES = 0		55	60	ps
		DOUBLE_RES = 1		27	30	
标准偏差	σ	DOUBLE_RES = 0	测量时间 100ns	35		ps
			测量时间 1000ns	37		
		DOUBLE_RES = 1	测量时间 100ns	26		
			测量时间 1000ns	32		
测量范围	t_M	非校准测量	3.5ns		25 μs	
		自校准测量	3.5ns		16 μs	

时钟振荡器

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高速晶振参考时钟	Clk_{HS}		1	4	8	MHz
陶瓷晶振起振时间	t_{OSZST}			100		μs
石英晶振起振时间	t_{OSZST}			5		ms

功能描述

1. SPI 接口

MS1006N 的 SPI 接口是与 4 线制 SPI 兼容的，它需要一个 SerialSelectNot(SSN)信号，从而不能够工作在 3-线制 SPI 接口。

SSN 的下降沿或者第一个 SCK 的上升沿将会复位 INTN 管脚（中断管脚）状态。

从最高位(MSB)开始传输以最低位(LSB)结束。传输是以字节方式完成的。数据传输可以在每个字节后停止，通过给 SSN 发送一个 LOW-HIGH-LOW 的电平。

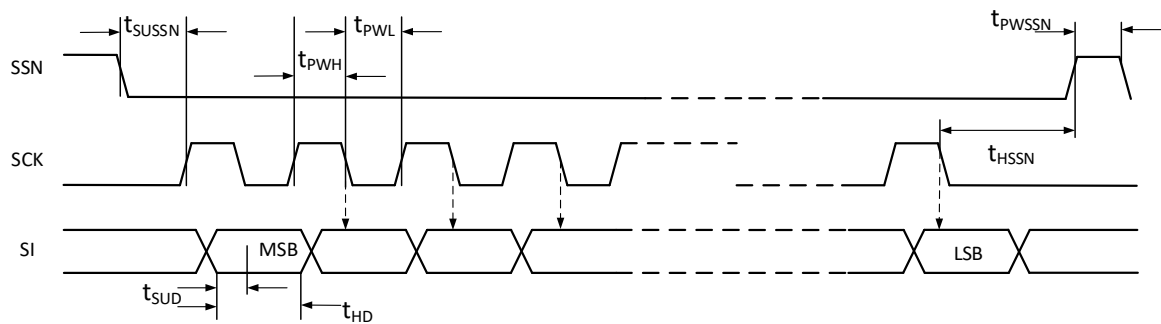


图 1. SPI 写时序

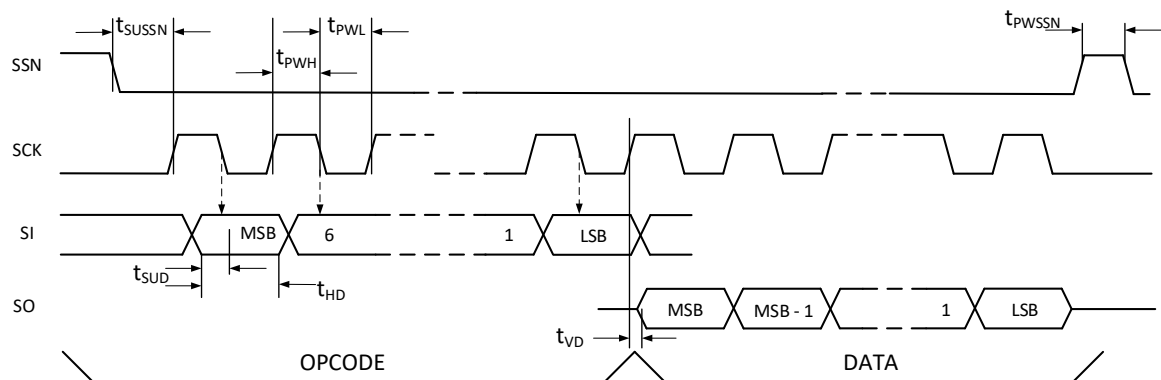


图 2. SPI 读时序

参数	符号	V _{DD} =2.5V	V _{DD} =3.3V	单位
串行时钟频率	f _{CLK}	25（最大值）	40（最大值）	MHz
串行时钟, 脉冲高	t _{PWH}	20（最小值）	12（最小值）	ns
串行时钟, 脉冲低	t _{PWL}	20（最小值）	13（最小值）	ns
SSN 开启到时钟沿有效	t _{SUSSN}	20（最小值）	20（最小值）	ns
SSN 在写循环之间的脉冲宽度	t _{PWSSN}	25（最小值）	25（最小值）	ns
SSN 在 SCK 下降沿后的保持时间	t _{HSSN}	15（最小值）	15（最小值）	ns
数据有效到 SCK 下降沿的时间	t _{SUD}	5（最小值）	5（最小值）	ns
数据在 SCLK 下降沿后的保持时间	t _{HD}	5（最小值）	5（最小值）	ns
在 SCK 上升沿到数据有效的时间	t _{VD}	15（最小值）	10（最小值）	ns

2. 关闭 STOP 通道的时序

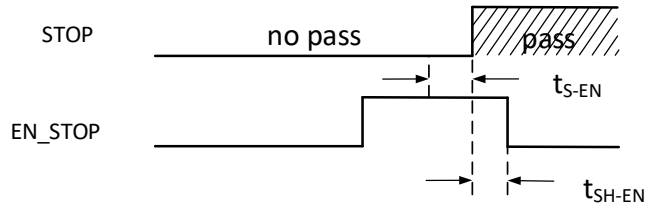


图 3. 关闭 STOP 通道时序

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
使能建立时间	t_{S-EN}		3.5			ns
使能保持时间	t_{SH-EN}		15			ns

3. 系统复位时序

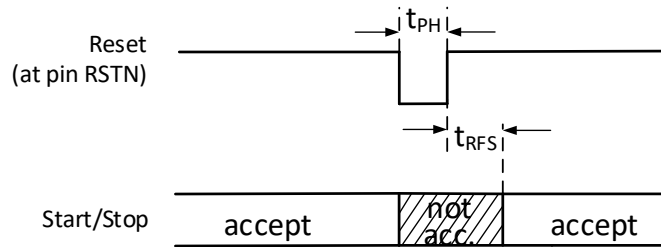


图 4. 系统复位时序

参数	符号	最小值	最大值	单位
复位脉冲宽度	t_{PH}	30		ns
在复位脉冲上升沿后到可以接受脉冲的时间间隔	t_{RFS}	30		ns

4. 操作码及寄存器

4.1 配置寄存器

MS1006N 有 1 组 32 位的配置寄存器。

位	默认	参数	描述	设置
31	0	HITIN2	在 stop 通道 2 的预期脉冲数	0 = stop 通道关闭 2 = 1 个脉冲； 3 = 2 个脉冲； 4 = 3 个脉冲； 5 = 4 个脉冲； 6 = 5 个脉冲； 7 = 6 个脉冲； 8 = 7 个脉冲； 9 = 8 个脉冲； A = 9 个脉冲； B = 10 个脉冲； 1,C 到 F = 不允许设置 STOP1 不能设置为 0
30	0			
29	1			
28	0			
27	0	HITIN1	在 stop 通道 1 的预期脉冲数	
26	0			
25	1			
24	0			
23	0	SEL_TIMO	溢出时间选择（使该功能有效必须 EN_SEL_TIMO=1，同时高速晶振需要 开启） 另外该溢出时间仅和高速时钟相关	0 = 1-2 个主时钟周期@500ns 1 = 3-4 个主时钟周期@1μs 2 = 7-8 个主时钟周期@2μs 3 = 15-16 个主时钟周期@4μs @ 4 MHz ClkHS
22	0			
21	0	DIV_CLKHS	设置 CLKHS 高速参考时钟的分频因数	0 = 不分频 ， 1 = 2 分频 2 = 4 分频 ， 3 = 8 分频
20	0			
19	0	START_CLKHS	设置晶振的开启和关闭（晶振关闭 后可以进行非校准模式测试，自动产生 CAL 值除外）	0 = 晶振关闭 1 = 晶振一直开启
18	1	DOUBLE_RES	双精度测量开启 （当开启双精度时，只能使用 STOP1 通道，STOP2 通道无效）	0 = 关闭 1 = 开启
17	1	EN_ERR_VAL	由于时间溢出强迫 ALU 写入 0xFFFFFFFF 到结果寄存器 （仅校准模式有效）	0 = 关闭 1 = 开启
16	0	EN_FAST_INIT	启动快速初始化功能	0 = 关闭功能 1 = 启动功能
15	0	SEL_TSTO2	定义 EN_START 管脚功能 （如果设 SEL_TSTOP2 > 0 ， 那么 EN_START 内部上拉高电平）	0 = 输入高电平将开启 START 1 = START_TDC 输出 2 = STOP1 TDC 输出 3 = STOP2 TDC 输出
14	1			
13	1	CALIBRATE	开启/关闭 在 ALU 中的校准	0 = 校准关闭 1 = 校准开启
12	0	NO_CAL_AUTO	开启/关闭产生校准值（如需开启 CALIBRATE，该位则必须设置为 0）	0 = 在测量后自动产生校准值 1 = 关闭自动产生校准值功能
11	0	K.D	必须设置为默认值	

位	默认	参数	描述	设置
10	0	NEG_STOP2	反向 stop 通道 2 输入	0 = 上升沿触发 1 = 下降沿触发
9	0	NEG_STOP1	反向 stop 通道 1 输入	0 = 上升沿触发 1 = 下降沿触发
8	0	NEG_START	反向 start 通道 1 输入	0 = 上升沿触发 1 = 下降沿触发
7	0	EN_SEL_TIMO	溢出时间功能开启 (和 SEL_TIMO 功能配合使用)	0 = 关闭 1 = 开启
6	0	EN_INT[2:0]	INIT 输出中断源选择	Bit 6 = 1: Timeout 中断触发位
5	0			Bit 5 = 1: End Hits 中断触发位
4	0			Bit 4 = 1: ALU 中断触发位
3	0	K.D	必须设置为默认值	
2	0	INV_SDO	设置 SDO 串行数据输出位序 (推荐在非校准模式下读取测量结果时使用)	0: 读取数据从高位到低位输出 1: 读取数据, 先输出低 16 位数据, 再输出高 8 位数据 注意: 配置此位会影响测量结果读取、CAL 值读取、状态寄存器读取, 不影响配置寄存器读取
1	0	RFEDGE2	通道 2 的边沿敏感性	0 = 上升或下降沿 1 = 上升和下降沿
0	0	RFEDGE1	通道 1 的边沿敏感性	

4.2 操作码

操作码 HEX	MSB				LSB				符号	操作
'h80	1	0	0	0	0	0	0	0	写入配置寄存器	写入 32bit
'hBx	1	0	1	1	A	A	A	A	读取地址 STOP1 数据 A(0-9)	读出 24bit
'hCx	1	1	0	0	A	A	A	A	读取地址 STOP2 数据 A(0-9)	读出 24bit
'hBB	1	0	1	1	1	0	1	1	读取校验数据(CAL)	读出 24bit
'hBC	1	0	1	1	1	1	0	0	读取配置寄存器的低 8 位	读出 8bit
'hBD	1	0	1	1	1	1	0	1	读取状态(STAT)	读出 24bit
'h70	0	1	1	1	0	0	0	0	Init	初始化指令
'h50	0	1	0	1	0	0	0	0	Power_On_Reset	复位指令
'h04	0	0	0	0	0	1	0	0	Start_Cal_TDC	CAL 测量指令

4.3 结果寄存器

操作码	符号	位数	描述
B0	RES1_0	24	STOP1 测量结果 1, 非校准模式: REG[2] = 0: 24 位整数, 读取数据从高位到低位输出 REG[2] = 1: 24 位整数, 读取数据先输出低 16 位数据, 再输出高 8 位数据 校准模式: REG[2] = 0: 24 位固定浮点数, 高 8 位整数, 低 16 位小数 REG[2] = 1: 24 位固定浮点数, 高 16 位小数, 低 8 位整数
B1	RES1_1	24	STOP1 测量结果 2, 格式同 RES1_0
B2	RES1_2	24	STOP1 测量结果 3, 格式同 RES1_0
B3	RES1_3	24	STOP1 测量结果 4, 格式同 RES1_0
B4	RES1_4	24	STOP1 测量结果 5, 格式同 RES1_0
B5	RES1_5	24	STOP1 测量结果 6, 格式同 RES1_0
B6	RES1_6	24	STOP1 测量结果 7, 格式同 RES1_0
B7	RES1_7	24	STOP1 测量结果 8, 格式同 RES1_0
B8	RES1_8	24	STOP1 测量结果 9, 格式同 RES1_0
B9	RES1_9	24	STOP1 测量结果 10, 格式同 RES1_0
C0	RES2_0	24	STOP2 测量结果 1, 格式同 RES1_0
C1	RES2_1	24	STOP2 测量结果 2, 格式同 RES1_0
C2	RES2_2	24	STOP2 测量结果 3, 格式同 RES1_0
C3	RES2_3	24	STOP2 测量结果 4, 格式同 RES1_0
C4	RES2_4	24	STOP2 测量结果 5, 格式同 RES1_0
C5	RES2_5	24	STOP2 测量结果 6, 格式同 RES1_0
C6	RES2_6	24	STOP2 测量结果 7, 格式同 RES1_0
C7	RES2_7	24	STOP2 测量结果 8, 格式同 RES1_0
C8	RES2_8	24	STOP2 测量结果 9, 格式同 RES1_0
C9	RES2_9	24	STOP2 测量结果 10, 格式同 RES1_0
BB	CAL	24	REG[2] = 0: 24 位整数, 读取数据从高位到低位输出 REG[2] = 1: 24 位整数, 读取数据先输出低 16 位数据, 再输出高 8 位

校准模式: $\text{Time} = \text{RES_X} \times \text{Tref} \times \text{N}$, 当 $\text{N} = 1, 2, 4$ 或 8 。

非校准模式: $\text{Time} = \text{RES_X} \times 55\text{ps}$ ($\text{VDD}=3.3\text{V}$, 单精度)。

4.4 读取配置寄存器低 8 位

操作码	描述							
BC	7	6	5	4	3	2	1	0
	REG_bit7	REG_bit6	REG_bit5	REG_bit4	REG_bit3	REG_bit2	REG_bit1	REG_bit0

4.5 读取状态寄存器(STAT)

操作码	描述(REG[2] = 0)								
BD	23-20	19-16	15	14	13	12-9	8-5	4	3-0
	0	STOP2 结果 地址指针	0	时间 溢出	TDC 溢出	STOP2 脉冲数	STOP1 脉冲数	0	STOP1 结果 地址指针

操作码	描述(REG[2] = 1)								
BD	23	22	21	20-17	16-13	12	11-8	7-4	3-0
	0	时间 溢出	TDC 溢出	STOP2 脉冲数	STOP1 脉冲数	0	STOP1 结果 地址指针	0	STOP2 结果 地址指针

5. 时间测量

5.1 概述

非校准模式测量范围从 3.5ns 到 25μs (0-25μs 在两个 stop 通道之间测量)。

校准模式单精度测量范围从 3.5ns 到 16μs (0-16μs 在两个 stop 通道之间测量)。

校准模式双精度测量范围从 3.5ns 到 4μs (0-4μs 在两个 stop 通道之间测量)。

单精度模式典型精度为 55ps, 2 个 stop 通道相对于 start 通道。

双精度模式典型精度为 27ps, 仅 stop1 通道相对应 start 通道。

内置特殊防抖技术, 使测量时间高度精准。

20ns 的脉冲之间最小间隔。

两个 stop 通道可同时采集, 且每个 stop 通道最多 10 个脉冲。

每个 stop 通道可选择上升或下降沿捕获, 或者选择上升和下降沿同时捕获。

自动测量 START 和 STOP 脉冲之间的时间间隔, 无需再进行寄存器设置。

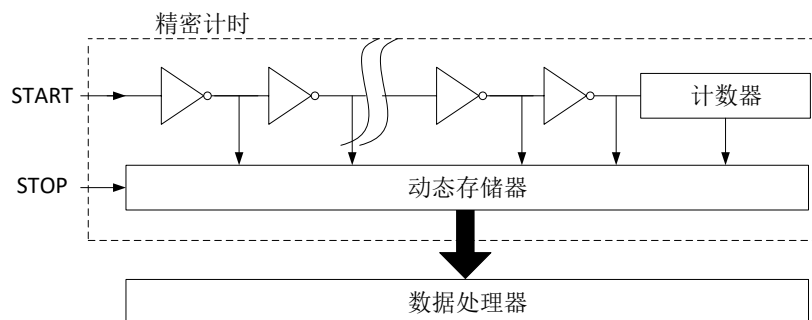
可任意设置溢出时间, 从而减少高速测量时溢出时间等待。

在非校准模式下, 可以任意测量比预期脉冲数少的脉冲。

典型应用: 激光测距、激光雷达、高精度延时测量。

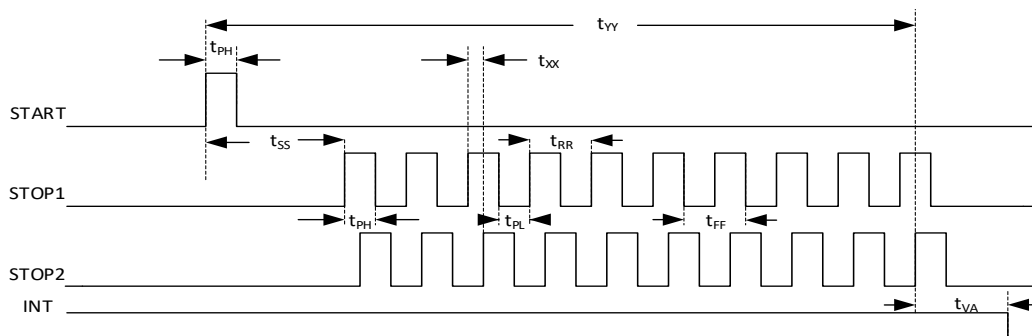
5.2 高精度时间测量原理

数字式 TDC 应用内部的逻辑门延时来高精度测量时间间隔, 下图阐述了这种绝对时间 TDC 的测量原理结构。该电路结构确保电路以特殊的测量方法, 使信号通过逻辑门的时间可以非常精确。最高的测量精度完全取决于内部通过逻辑门的传播时间。



时间测量是通过一个 start 信号触发,通过内部防抖处理后, TDC 的门电路开始高速计数,直到 stop 信号产生记录计数结果,达到 STOP 预期脉冲数后停止计数。

3.3V 和 25°C 时, MS1006N 的单精度最小分辨率是 55ps。温度和电压对门电路的传播延时时间有很大的影响。通常是通过校准来补偿由温度和电压变化而引起的误差。在校准过程中, TDC 测量 0.5 个和 1.5 个时钟周期,相减后得一个时钟周期的 TDC 计数结果,即为校准值。测量范围受计数器大小的限制,以下是非校准模式下最大测量范围: $t_{vy} = 60ps \times 442368 \approx 25\mu s$ 。



	时间 (条件)	描述
t_{PH}	2.5ns (Min.)	最小脉冲宽度
t_{PL}	2.5ns (Min.)	最小脉冲宽度
t_{SS}	3.5ns (Min.) 25 μs (Max.)	Start 到 Stop 之间
t_{RR}	20ns (Typ.)	上升沿到上升沿
t_{FF}	20ns (Typ.)	下降沿到下降沿
t_{VA}	t.b.d. 非校准 t.b.d. 校准后	最后一个脉冲到 INIT 输出时间 (详见“INTN 不同模式下产生时间”)
t_{XX}	无时间限制	通道之间测量时间
t_{VY}	25 μs (Max.)	最大测量范围

每一个输入端均可以被单独设置成上升沿、下降沿或上下沿同时触发有效。可通过设置寄存器的 bit8-10 位(NEG_START, NEG_STOP1, NEG_STOP2)和寄存器的 bit0-1 位(REFDGEx) 来选择触发沿。

时间测量结束后，MS1006N 会自动将各个脉冲的测量结果顺序写到相应的结果寄存器，无需再进行寄存器操作设置，在计算结果的过程中先计算 STOP1 通道的脉冲，然后计算 STOP2 通道的脉冲，所以当使用单通道时，必须使用 STOP1。

5.3 非校准时间测量

5.3.1 非校准时间测量概述

非校准时间测量，实际上就是应用数字式 TDC 内部的逻辑门延时来实现高精度时间测量，非校准模式下最大测量范围是 3.5ns-25μs，单精度模式下，可以两个 STOP 通道同时测量，且每个通道最多可以测量 10 个 STOP 脉冲，双精度模式下，仅 STOP1 通道可以使用。

非校准时间测量过程中，无需高速时钟参与，所以可以通过寄存器设置来关闭高速时钟 (START_CLKHS=0)，在该模式下，测量速度最快，结果寄存器直接输出门延时个数，在非校准模式下结果寄存器 20 位的有效位，测量时间计算如下，该测量时间受温度和电压影响。

$$\text{测量时间} = \text{RES_X} \times 55\text{ps} \quad (\text{DOUBLE_RES}=0)$$

$$\text{测量时间} = \text{RES_X} \times 27\text{ps} \quad (\text{DOUBLE_RES}=1)$$

非校准模式下也可以实现时间测量和 CAL 值同时测量，在该模式下需要开启高速时钟 (START_CLKHS=1) 和开启自动校准 (NO_CAL_AUTO=0)，这样就会测量时间的同时会产生一个 $T_{\text{ref}} \times N$ 周期的门延时个数，然后将 CAL 值 RES_Tref 存在指定的结果寄存器中。测量时间如下计算，该测量时间和温度和电压无关，仅和高速时钟抖动有关。

$$\text{测量时间} = \text{RES_X} \times (T_{\text{ref}} \times N / \text{RES_Tref}), N = 1, 2, 4, 8$$

非校准模式测量溢出，当溢出时间功能关闭 (EN_SEL_TIMO=0) 的情况下，溢出时间相当于 TDC 溢出，也就是要 25μs 后产生溢出，并且状态寄存器 Bit13=1 (TDC 溢出)；当溢出时间功能开启 (EN_SEL_TIMO=1) 的情况下，溢出时间由溢出时间选择 (SEL_TIMO) 进行设置，溢出时间仅和高速时钟相关，不受时钟分频 (DIV_CLKHS) 的影响，例如高速时钟为 8MHz，SEL_TIMO=0 的情况下，溢出时间为 250ns，溢出时状态寄存器 Bit14=1 (时间溢出)。

非校准模式下，当测量脉冲个数小于预期脉冲个数时，可以正常输出测量脉冲的值，虽然这时状态寄存器溢出，但测量到的脉冲产生的结果是正确的，这种应用可以解决在测距过程中多个不定目标的问题。

*特别提醒：非校准模式下，对于单精度测量时间间隔在 3μs 以内，可以设置 REG[2] = 1，只读低 16 位结果，可以加快读取时间。

5.3.2 寄存器设置

主要的设置为：

(1) 选择测量预期脉冲个数

寄存器 bit 31-28 设置 STOP2 预期脉冲个数 HITIN2=0 或者 2-B；

寄存器 bit 27-24 设置 STOP1 预期脉冲个数 HITIN1=2-B，不能设置为 0；否则无法开启测量。

(2) 选择测量精度

寄存器 bit 18, DOUBLE_RES = 1 选择双精度模式, 测量精度为典型 27ps, 但仅有一个 stop 通道可用。
DOUBLE_RES = 0 选择单精度模式, 测量精度为典型 55ps, 这时两个 stop 通道都可用。

(3) 校准选择

在非校准模式下, 校准将关闭, 寄存器 bit 13 CALIBRATE=0;

(4) 产生 CAL 值

在非校准模式下, 可以选择产生 CAL 值和不产生 CAL 值, 寄存器 bit 12 NO_CAL_AUTO=0 时, 产生 CAL 值, NO_CAL_AUTO=1 时, 不产生 CAL 值。

(5) 溢出选择

在非校准模式下, 寄存器 bit 7 EN_SEL_TIMO=0 溢出时间关闭, 这时溢出时间为 TDC 溢出, 当 EN_SEL_TIMO=1 时开启溢出时间, 且溢出时间和寄存器 bit 23-22 SEL_TIMO 设置有关。

(6) 选择输入触发方式

可通过设置寄存器的 Bit 8-10(NEG_X)在每一个输入端口(Start,Stop1,Stop2)边沿触发方式。当 RFEDGE=0 时, NEG_X=0 则上升沿触发, NEG_X=1 则下降沿触发。还可以通过设置寄存器的 Bit0&1 (RFEDGE1 & RFEDGE2), 选择 STOP 由上升沿或下降沿单独触发(RFEDGE=0), 还是上升沿和下降沿同时触发(RFEDGE=1), 当 RFEDGE=1 时, Bit 9-10 选择无效。

(7) 中断

中断引脚 INTN 可以有不同的中断源, 在寄存器的 Bit 4-6(EN_INT)中进行选择, 非校准模式选择 bit 6 = 1 和 bit 5 = 1;

Reg bit 4 = 1 ALU 已经准备好

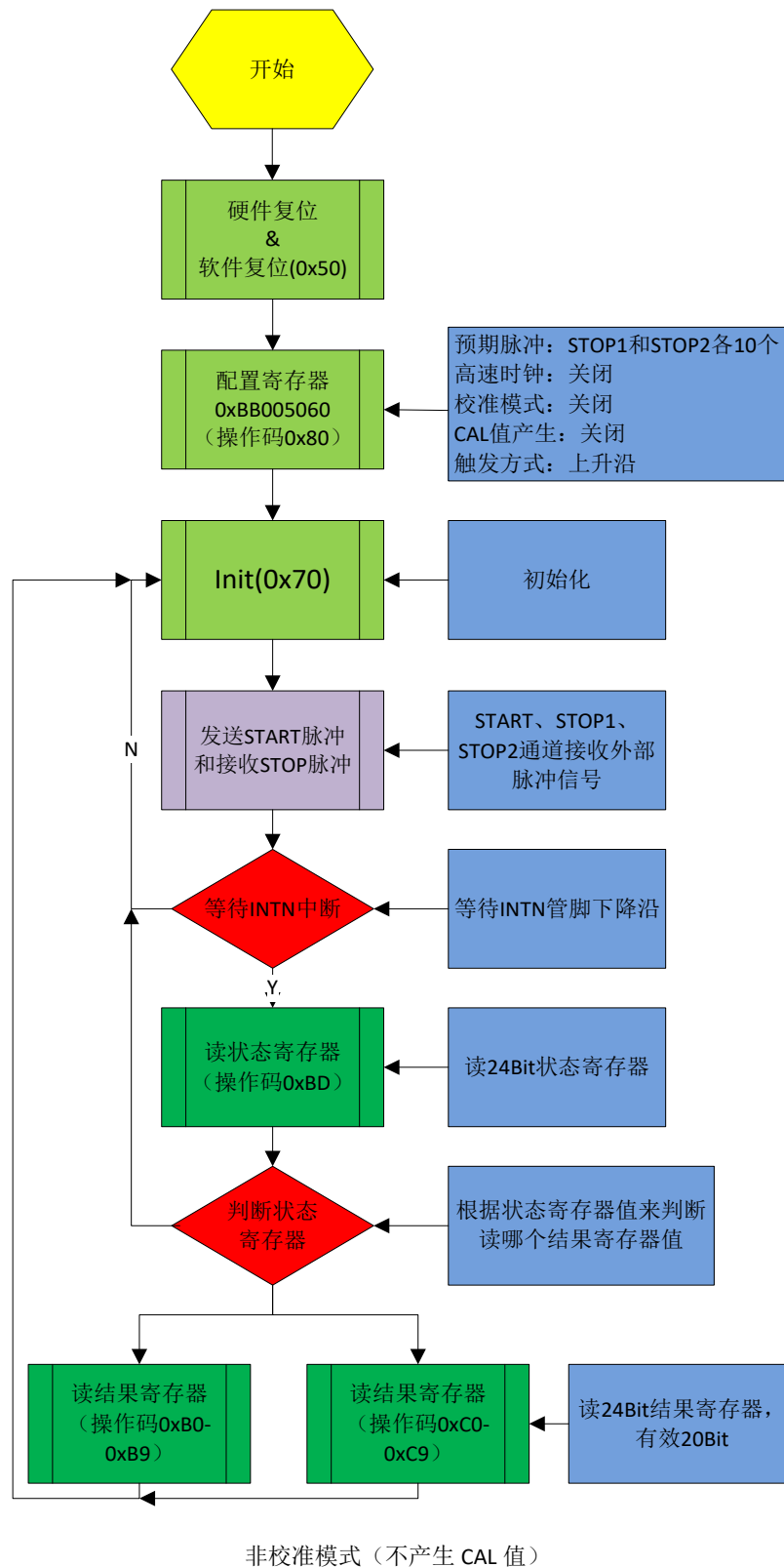
Reg bit 5 = 1 预期脉冲个数全部被接收到

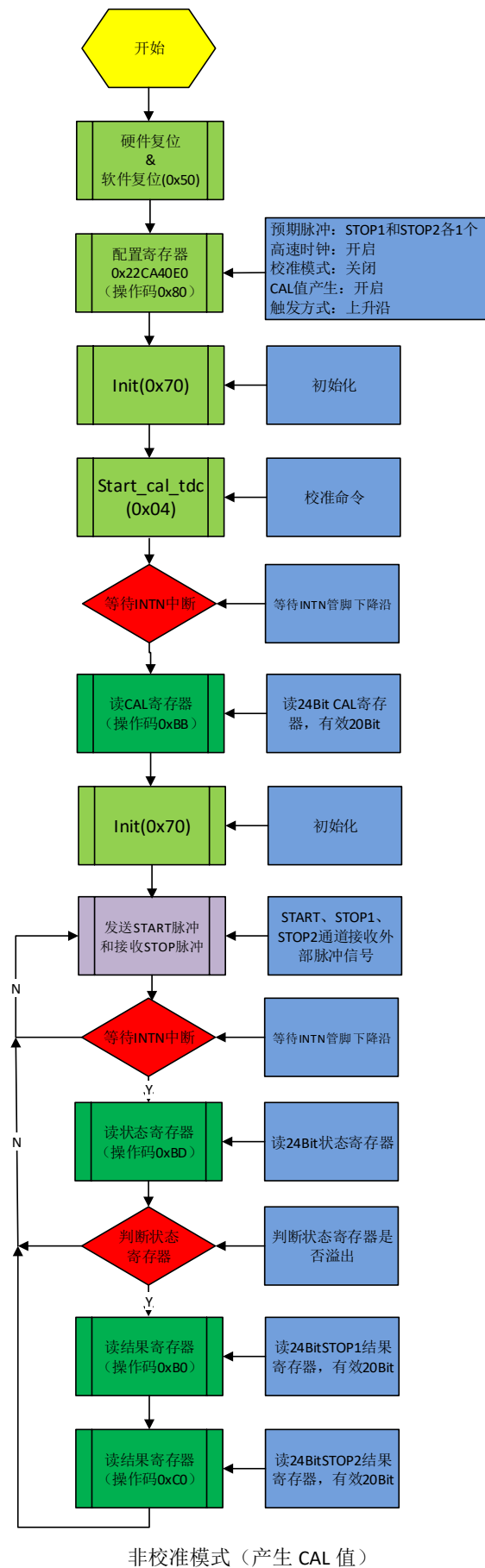
Reg bit 6 = 1 测量时间溢出

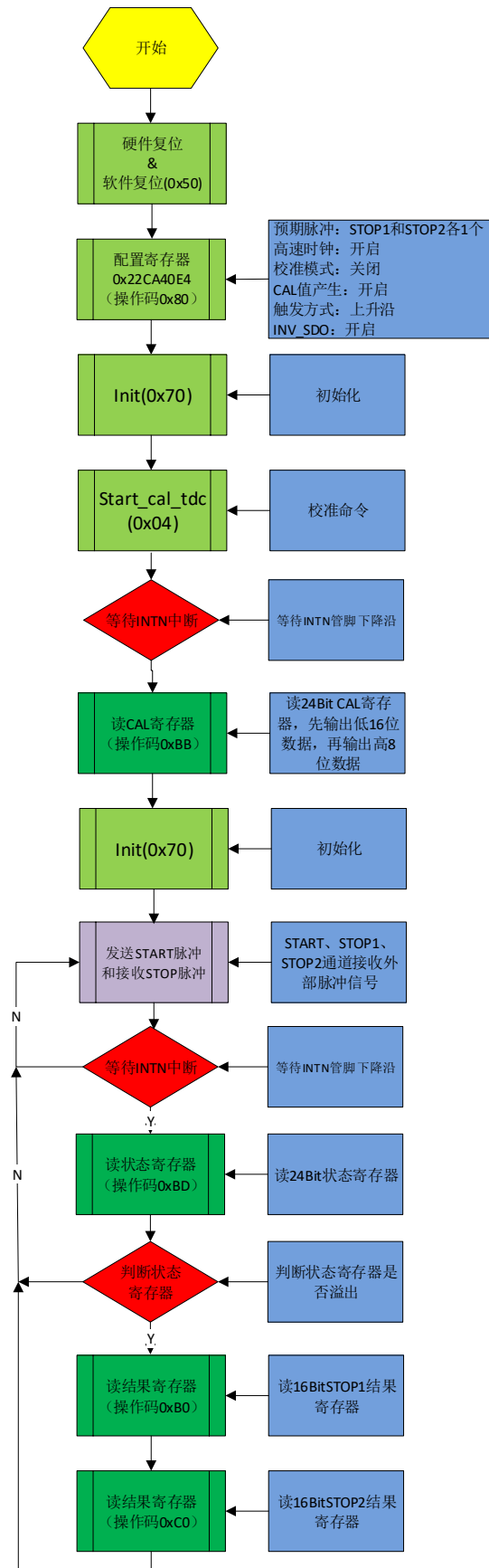
(8) 结果读取

Reg bit 2 = 1 读取数据, 先输出低 16 位数据, 再输出高 8 位数据 (单精度测量 3μs 以内高 8 位可以不读)

5.3.3 测量流程







非校准模式 (单精度测量 3us 以内时间间隔)

5.4 校准时间测量

注：校准测量单精度最大测量范围 16 μ s，双精度最大测量范围 4 μ s。

5.4.1 校准时间测量概述

校准时间测量，在高速振荡器开启情况下进行测量，测量的门延时数量和 Tref 门延时数量通过 ALU 进行计算并输出到结果寄存器。输出的结果为 24 位浮点数，高 8 位为整数位，低 16 位为小数位。校准模式下最大测量范围是 3.5ns-16 μ s，单精度模式下，可以两个 STOP 通道同时测量，且每个通道最多可以测量 10 个 STOP 脉冲，双精度模式下，仅 STOP1 通道可以使用。

校准时间测量过程中，需要开启高速时钟(START_CLKHS=1)和校准开启(CALIBRATE=1)，当产生校准值关闭(NO_CAL_AUTO=1)结果寄存器输出非校准值（可参考非校准部分介绍），当产生校准值开启(NO_CAL_AUTO=0)时，结果寄存器输出校准后的值 RES_X，测量时间如下计算，被测时差不能超过 $2 \times Tref \times DIV_CLKHS$ 。

$$\text{测量时间} = RES_X \times Tref \times N, N = 1, 2, 4, 8$$

在校准时间测量中，必须开启溢出时间功能(EN_SEL_TIMO=1)，溢出时间由溢出时间选择(SEL_TIMO)进行选择溢出时间，这里的时间仅和高速时钟相关，不受时钟分频(DIV_CLKHS)的影响，例如高速时钟为 8MHz，SEL_TIMO=0 的情况下，溢出时间为 250ns，这时状态寄存器 Bit14=1（时间溢出）。

校准模式下，测量脉冲个数必须大于或者等于预期脉冲个数，当测量脉冲小于预期脉冲个数时，ALU 不进行计算，这时状态寄存器 Bit14=1（时间溢出）。且 EN_ERR_VAL=1 的情况下，结果寄存器 0 输出全 F。

5.4.2 寄存器设置

主要的设置为：

(1) 选择测量预期脉冲个数

寄存器 bit 31-28 设置 STOP2 预期脉冲个数 HITIN2=0 或者 2-B；

寄存器 bit 27-24 设置 STOP1 预期脉冲个数 HITIN1=2-B，不能设置为 0；否则无法开启测量。

(2) 选择测量精度

寄存器 bit 18, DOUBLE_RES = 1 选择双精度模式，测量精度为典型 27ps，但仅有一个 stop 通道可用。

DOUBLE_RES = 0 选择单精度模式，测量精度为典型 55ps，这时两个 stop 通道都可用。

(3) 校准选择

在校准模式下，高速晶振和校准都必须开启，寄存器 bit 13 CALIBRATE=1 和 bit 19 START_CLKHS=1

(4) 产生 CAL 值

在校准模式下，必须选择产生 CAL 值，寄存器 bit 12 NO_CAL_AUTO=0 时，产生 CAL 值。

(5) 溢出选择

在校准模式下，必须开启溢出，寄存器 bit 7 EN_SEL_TIMO=1 开启溢出时间，且溢出时间和寄存器 bit 23-22 SEL_TIMO 设置有关。

(6) 选择输入触发方式

可通过设置寄存器的 Bit 8-10(NEG_X)在每一个输入端口(Start,Stop1,Stop2)边沿触发方式。当 RFEDGE = 0 时, NEG_X = 0 则上升沿触发, NEG_X = 1 则下降沿触发。还可以通过设置寄存器的 Bit0&1(RFEDGE1 & RFEDGE2), 可以选择 STOP 下降沿单独触发(RFEDGE=0), 还是上升沿和下降沿同时触发(RFEDGE=1), 当 RFEDGE=1 时, Bit 9-10 选择无效。

(7) 中断

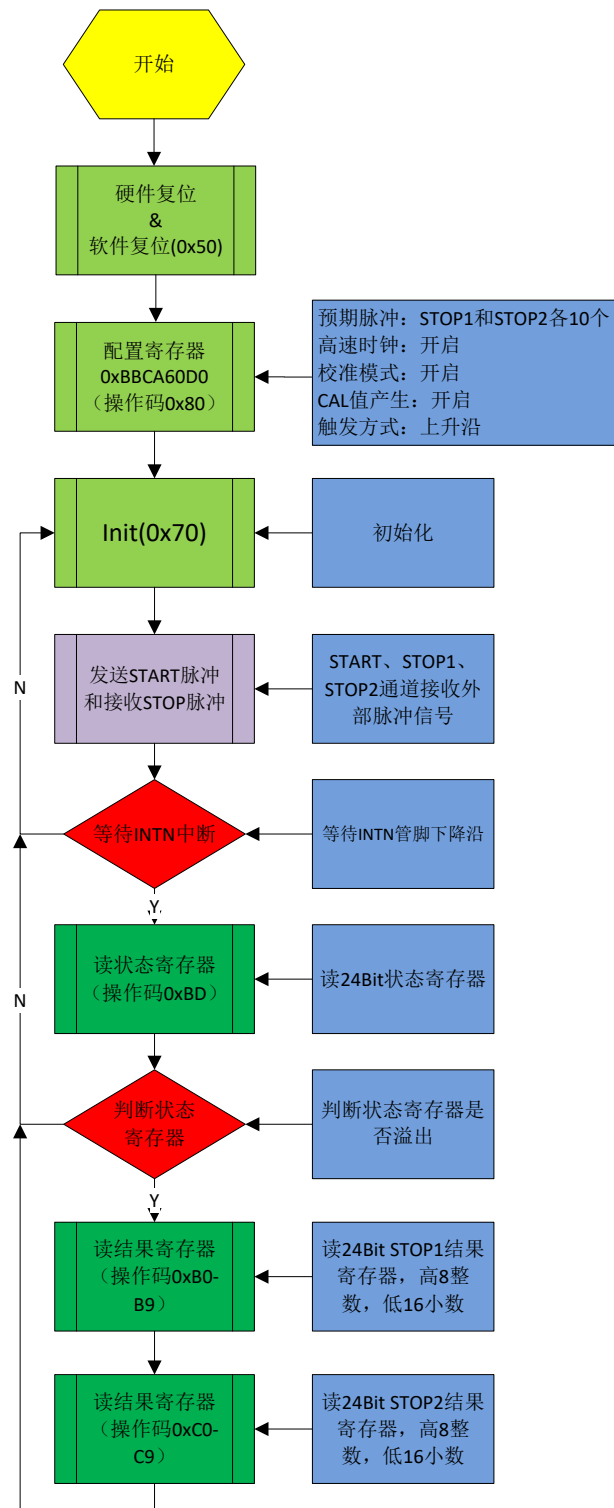
中断引脚 INT 可以有不同的中断源, 在寄存器的 Bit 4-6(EN_INT)中进行选择, 由于 Reg bit 5=1 中断输出最早, Reg bit 4=1 输出最晚, 用户可以根据实际情况进行选择。

- Reg bit 4 = 1 ALU 已经准备好
- Reg bit 5 = 1 预期脉冲个数全部被接收到
- Reg bit 6 = 1 测量时间溢出&TDC 溢出

(8) 高速时钟分频

由于校准测量时间小于 $2 \times T_{ref} \times DIV_CLKHS$ (T_{ref} 只与外接高速晶振相关, 如外接 4M, 则 $T_{ref} = 250ns$), 所以需要测量时间增长的话, 需要设置高速时钟分频, 在寄存器的 Bits20-21(DIV_CLKHS)中进行设置, 但 $2 \times T_{ref} \times DIV_CLKHS$ 不能超出测量范围最大值 $16\mu s$ 。

5.4.3 测量流程



校准模式

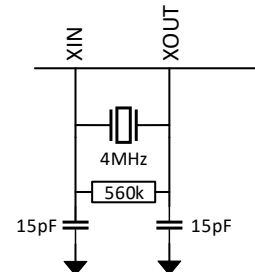
6. 高速振荡器

MS1006N 在校准模式下需要高速时钟用于校准采样，通常 MS1006N 会需要一个高速时钟单元进行校准，频率范围 1-8MHz，推荐高速时钟频率为 4MHz。

晶振在一直起振的状态下，平均工作电流为 220 μ A。但是晶振仅在测量时间的时候需要开启，MS1006N 可以通过内部电路控制晶振的开启和关闭。设置是通过设置参数 START_CLKHS 来实现。

START_CLKHS = 0 晶振关闭
= 1 晶振持续开启

通过关闭晶振这种方式电流消耗可以大大被降低。

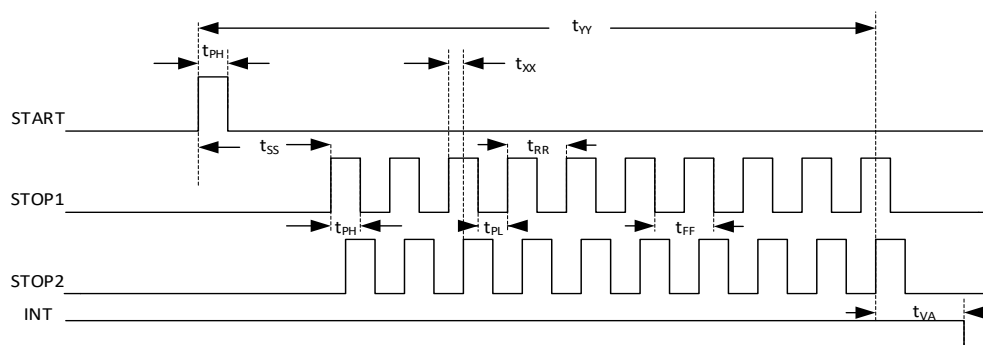


7. 快速初始化

MS1006N 提供了快速初始化的功能。设置寄存器的 bit16(EN_FAST_INIT)=1，中断标志会自动初始化 TDC。因此在读出数据时 TDC 就已经准备好进行下次测量了。这种模式只适用于高速应用中。这对于只有一个 STOP 信号的非校准测量模式下尤其适合。在快速初始化模式下，状态寄存器的值永远是 0，所以无需再读状态寄存器。

8. INTN 不同模式下产生时间

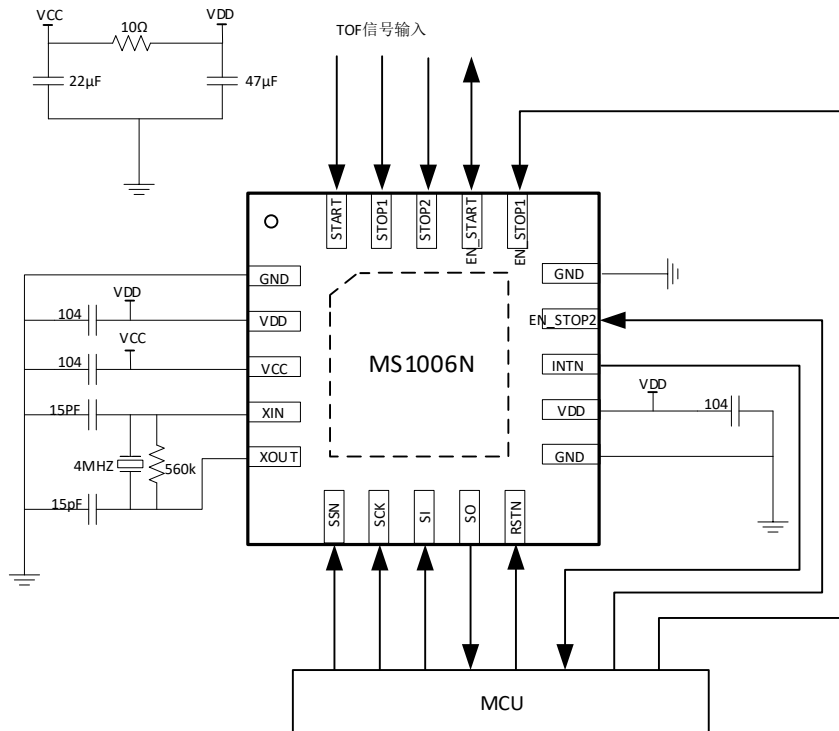
INIT 是整个测试流程的重要标志位，INTN 是和 EN_INT[2:0]来配合使用，不同的中断源输出中断时间不一样，如下图 t_{VA} 的时间为 INTN 产生时间，具体如下：



名称	条件（以下测试高速时钟均为 4MHz）	数值	单位
tinit1	VCC=3.3V; EN_INT: End Hits=1; 非校准模式；关闭 CAL 校准； 预期 1 个 STOP 脉冲，并获得一个脉冲。	30	ns
tinit2	VCC=3.3V; EN_INT: ALU=1; 非校准模式；关闭 CAL 校准； 预期 1 个 STOP 脉冲，并获得一个脉冲。	150	ns
tinit3	VCC=3.3V; EN_INT: ALU=1; 非校准模式；开启 CAL 校准； 预期 1 个 STOP 脉冲，并获得一个脉冲。	1500	ns
tinit4	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 非校准模式；溢出关闭； 预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	25	ns

名称	条件（以下测试高速时钟均为 4MHz）	数值	单位
tinit5	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 非校准模式；溢出开启， 且 SEL_TIMO_MB2=0；预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	400	ns
tinit6	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 非校准模式；溢出开启， 且 SEL_TIMO_MB2=1；预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	1000	ns
tinit7	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 非校准模式；溢出开启， 且 SEL_TIMO_MB2=2；预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	2000	ns
tinit8	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 非校准模式；溢出开启， 且 SEL_TIMO_MB2=3；预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	4000	ns
tinit9	VCC=3.3V; EN_INT: ALU=1; 校准模式；开启 CAL 校准，溢出开启； 且 SEL_TIMO_MB2=0；预期 1 个 STOP 脉冲，并获得一个脉冲。	2200	ns
tinit10	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 校准模式；开启 CAL 校准；溢出开启， 且 SEL_TIMO_MB2=0；预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	400	ns
tinit11	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 校准模式；开启 CAL 校准；溢出开启， 且 SEL_TIMO_MB2=1；预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	1000	ns
tinit12	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 校准模式；开启 CAL 校准；溢出开启， 且 SEL_TIMO_MB2=2；预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	2000	ns
tinit13	VCC=3.3V; EN_INT: Timeout=1; 校准模式；开启 CAL 校准；溢出开启， 且 SEL_TIMO_MB2=3；预期 1 个 STOP 脉冲，未获得一个脉冲。	4000	ns

典型应用图



为了达到最佳测量效果，好的电源非常重要。电源应该具有高电容性和低电感性。MS1006N 提供两对电源供应端口：VCC - I/O 供电电压，VDD - 内核供电电压。

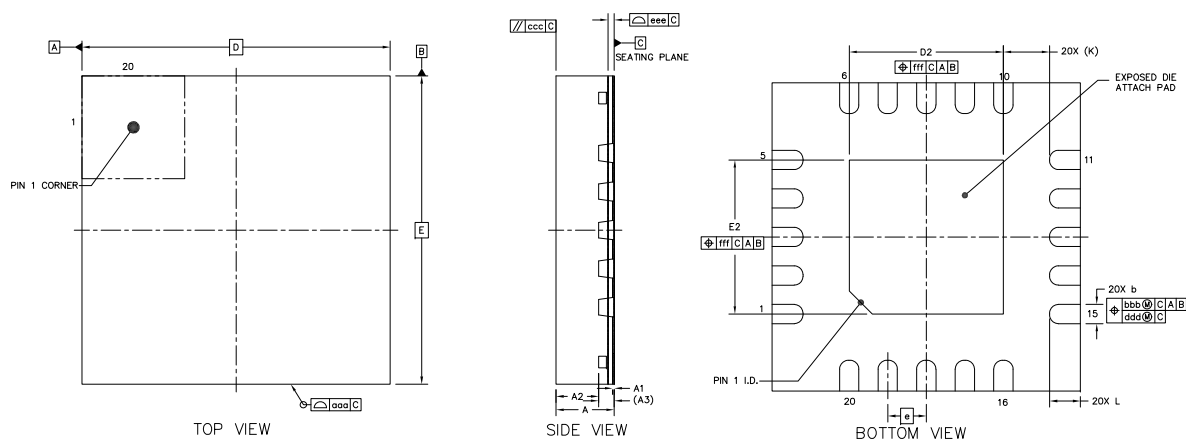
所有的 Ground 引脚都应该连接到印刷电路板的地层上。VCC 和 VDD 应该通过一个电池或者固定的线性电压调节器给出。不要应用开关式的调节器，避免由于 IO 电压引起的干扰。

时间数字转换器能够有好的测量效果，完全取决于好的电源供电。芯片测量主要是脉冲式的电流，因此一个充足的双通滤波非常重要：VCC 47 µF（最小 22 µF），VDD 100 µF（最小 22 µF）。

电压应用通过一个模拟的调节器给出，推荐不要使用开关式的电压调节。

封装外形图

QFN20



符号	尺寸 (毫米)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.7	0.75	0.8
A1	0	0.02	0.05
A2	-	0.55	-
A3	0.203 REF		
b	0.2	0.25	0.3
D	4 BSC		
E	4 BSC		
e	0.5 BSC		
D2	1.9	2	2.1
E2	1.9	2	2.1
L	0.3	0.4	0.5
K	0.6 REF		
aaa	0.05		
ccc	0.1		
eee	0.08		
bbb	0.1		
ddd	0.05		
fff	0.1		

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：MS1006N

生产批号：XXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	颗/卷	卷/盒	颗/盒	盒/箱	颗/箱
MS1006N	QFN20	4000	1	4000	8	32000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

**MOS电路操作注意事项**

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室

[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)